

บทที่ 9

การอธิบายปรากฏการณ์สำคัญโดยหลักสถิติ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการแฝรั้งสีของวัตถุดำโดยหลักสถิติทางอุณหพลศาสตร์และทฤษฎีความต้มได้
2. แสดงกฎการแจกแจงพลังงานของโฟตอนโดยหลักสถิติของบีบีส-ไอน์สไตน์ได้
3. หาค่าต่าง ๆ ทางอุณหพลศาสตร์หรือเทอร์โมไดนามิกส์สำหรับการแฝรั้งสีของวัตถุดำได้
4. อธิบายสมบัติของอิเล็กตรอนอิสระที่เกี่ยวข้องกับการนำความร้อนและการนำไปฟื้นของโลหะต่าง ๆ ได้
5. เปรียบเทียบลักษณะการแจกแจงของอิเล็กตรอนอิสระกับก้ามโดยทั่วไปได้
6. แสดงพังก์ชันการแจกแจงที่ถูกต้องสำหรับอิเล็กตรอนอิสระได้
7. ชี้แจงความหมายของพลังงานเฟร์มีในการณ์ของอิเล็กตรอนอิสระได้
8. หาค่าต่าง ๆ ของอิเล็กตรอนอิสระได้

เก้าโครงเรื่อง

1. การแฝรั้งสีของวัตถุดำ
 - 1.1 ความหมายของวัตถุดำ
 - 1.2 จำนวนโฟตอนของการแฝรั้งสี
 - 1.3 ความหนาแน่นของพลังงาน
 - 1.4 การเปรียบเทียบกับกฎลฐานต่าง ๆ
2. การหาค่าต่าง ๆ ของการแฝรั้งสีของวัตถุดำ
 - 2.1 ความดันของการแฝรั้งสี
 - 2.2 พลังงานทั้งหมดของระบบ
 - 2.3 ความถูความร้อนของระบบ

2.4 เอนໂທຣປຶ່ງຂອງຮະບນ

2.5 ພັກໜັນເຂົ້ມໂຂລສ໌ຂອງຮະບນ

2.6 ພັກໜັນກົບສ໌ຂອງຮະບນ

3. ອີເລີກຕາວອິສະຣະໃນໄລ້ທະ

3.1 ຄຸນລັກຊະນະຂອງອີເລີກຕາວອິສະຣະໃນໄລ້ທະ

3.2 ກາຣແຈກແຈງຂອງອີເລີກຕາວອິສະຣະ

3.3 ພັກໜັນເພົ່ມ

3.4 ກາຣຫາຄ່າສັກຍໍທາງເຄມື່ອງ

3.5 ພລັງງານເພົ່ມ

4. ກາຣຫາຄ່າຕ່າງ ຖ້າຂອງອີເລີກຕາວອິສະຣະ

4.1 ພລັງງານທັງໝດຂອງອີເລີກຕາວອິສະຣະ

4.2 ດວາມຮ້ອນຈຳເພະນະຂອງອີເລີກຕາວອິສະຣະ

4.3 ເອນໂທຣປຶ່ງຂອງອີເລີກຕາວອິສະຣະ

4.4 ພັກໜັນເຂົ້ມໂຂລສ໌ຂອງອີເລີກຕາວອິສະຣະ

4.5 ດວາມດັນຂອງກໍາຊອງເລີກຕາວອິສະຣະ

(หน้า 494-499)

การแฝ่รังสีของวัตถุดำ

คำอธิบายศัพท์/จำนวน

1. การแฝ่รังสีของวัตถุดำ คือ การแฝ่ลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในทุกขนาดช่วงคลื่นหรือทุกระดับพลังงานตั้งแต่ศูนย์ถึงอนันต์ จากวัตถุซึ่งสามารถรับพลังงานของการแฝ่รังสีที่ تمامายังวัตถุนั้นได้ทั้งหมดทุกขนาดช่วงคลื่น เมื่อศึกษาจากวัตถุดำภายในสัญญาณซึ่งล้อมรอบด้วยผนังทึบ ขณะที่อยู่ในสถานะคงตัวปรากฏว่าอัตราการรับรังสีที่ تمامายังวัตถุนั้นจะเท่ากับอัตราการแฝ่รังสีออกจากวัตถุ โดยการแฝ่รังสีจะขึ้นกับอุณหภูมิของผนังที่ล้อมรอบ

2. โฟตอน คือ หน่วยพลังงานของแสงหรือการแฝ่ลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเรียกว่าความต้มโดยมีค่าตามขนาดความถี่ของแสงหรือคลื่นเท่ากับผลคูณของค่าคงตัวของพลังค์กับความถี่นั้น

สรุปประเด็นสำคัญ

โดยการพิจารณาการแฝ่รังสีของวัตถุดำตามหลักสถิติโบส-ไอ้นสไตน์ เนื่องจากรังสีประกอบด้วยอนุภาคโฟตอนซึ่งไม่มีความแตกต่างกันและไม่มีจุดจำกัดใด ๆ ในการกระจายอนุภาค ปรากฏว่าได้ผลตรงกับกฎของพลังค์ที่ได้จากการทดลอง และตรงกับกฎของสเตฟานที่ได้จากการทดลองด้วย

กิจกรรมการเรียนที่ 1

1. ทบทวนเนื้อหาหัวข้อที่ 1 จากตำราเรียนด้วยตนเองแบบโปรแกรมสำหรับระบบวิชานี้ (รหัสการพิมพ์ 29241) หน้า 494-499 หรือฟังคำบรรยายสรุปจากແນບคำบรรยายสรุปสำหรับระบบวิชานี้ ครั้งที่ 10 (ดูบันทึกท้ายเล่ม) ประกอบด้วยภาพไปรษณีย์ แผ่นที่ 61-62 (ดูแบบท้ายเล่มนี้)
2. แสดงรูปแบบฟังก์ชันการแจกแจงสำหรับการแฝ่รังสีของวัตถุดำตามหลักสถิติโบส-ไอ้นสไตน์ และเปรียบเทียบกับผลการทดลองตามกฎต่าง ๆ

(หน้า 500-504)

การหาค่าต่าง ๆ ของการแฝ่รังสีของวัตถุดำ

คำอธิบายศัพท์/จำนวน

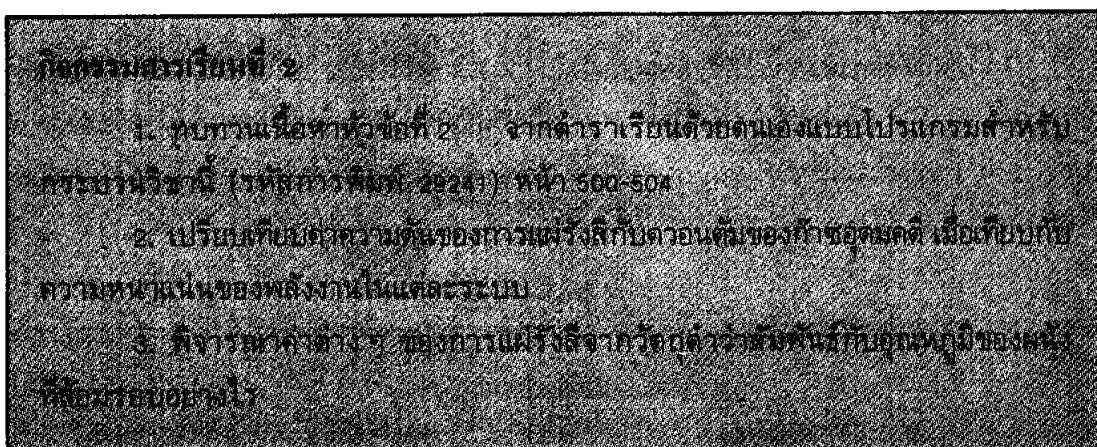
1. ความดันของการแฝ่รังสี คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงานต่อปริมาตร ซึ่งจะลดลงเมื่อปริมาตรเพิ่มขึ้น ตามค่าจำกัดความดังนี้ ความดัน $P = -\frac{dE}{dV}$ จะได้ ความดันเฉลี่ย

จากโฟตตอนของการแฝรั้งสีทั้งหมด $\bar{P} = \sum \bar{N}_j (-\partial \epsilon_j / \partial V)$

2. พลังงานทั้งหมดของการแฝรั้งสี คือ พลังงานของระบบโฟตตอนซึ่งมีขนาดความถี่ต่าง ๆ กัน ภายใต้ปริมาตร V ดังนั้น จะหาพลังงานทั้งหมดของระบบโฟตตอนได้จากการรวมหนาแน่นของพลังงานคุณกับปริมาตร และพลังงานทั้งหมดของระบบคือพลังงานภายในของระบบ

สรุปประเด็นสำคัญ

ความดันของการแฝรั้งสีขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของพลังงานการแฝรั้งสี โดยที่พลังงานทั้งหมดของระบบคือพลังงานภายในของระบบ จึงหากความจุความร้อนของวัตถุจะได้จากการรวมภายในขณะที่ปริมาตรคงที่ ส่วนค่าอื่น ๆ จะหาได้จากการรวมพันธ์ตามที่ได้ศึกษาแล้วในอุณหพลศาสตร์แผนเดิม



(หน้า 505-518)

อิเล็กตรอนอิสระในโลหะ

คำอธิบายศัพท์/จำนวน

1. กําช อิเล็กตรอน คือ อิเล็กตรอนอิสระในโลหะซึ่งสามารถเคลื่อนออกจากวงนอกสุดของอะตอมในโครงสร้างแลตทิซได้โดยง่าย จึงกระจายอยู่บริเวณผิวโลหะ เป็นตัวการในการนำไฟฟ้าและความร้อน ซึ่งทำให้โลหะเป็นตัวนำที่ดีได้ อิเล็กตรอนอิสระซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปในขอบเขตของผิวโลหะ จึงเปรียบเสมือนอนุภาคกําชซึ่งพุ่งกระจายอยู่ภายนอกในภาชนะที่บรรจุกําชนั้น จึงเรียกอิเล็กตรอนอิสระนี้ว่า กําช อิเล็กตรอน แต่การแจกแจงของอิเล็กตรอนอิสระต่างกับในกรณีของกําชทั่วไป โดยระบบอิเล็กตรอนอิสระจะเป็นระบบตามหลักสถิติเฟร์มี-ดิแรก นอกจากนี้ ความดันของกําชอิเล็กตรอนจะมีมากกว่าของกําชทั่วไปหลายแสนเท่า

2. พลังงานเฟร์มี คือ พลังงานสูงสุดที่อิเล็กตรอนอิสระในโลหะจะมีได้ที่อุณหภูมิศูนย์ สัมบูรณ์ ในขณะที่พลังงานเฉลี่ยของกําช อุ่นคติเป็นศูนย์ที่ศูนย์สัมบูรณ์ แต่สำหรับอิเล็กตรอน อิสระจะมีค่าสูงกว่ามาก และที่อุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้อิเล็กตรอนมีพลังงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก พลังงานเฟร์มี ถ้าอุณหภูมิไม่สูงมากนักจะมีอิเล็กตรอนอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนอิเล็กตรอน ทั้งหมดที่ระดับเฟร์มี โดยที่ศูนย์สัมบูรณ์จะมีการแจกแจงหนึ่งตัวต่อหนึ่งสภาวะอย่างเดียวที่

สรุปประเด็นสำคัญ

เมื่อพิจารณาอิเล็กตรอนอิสระในโลหะสมมูลกําชซึ่งประกอบด้วยอนุภาคอิเล็กตรอน กระจายโดยทั่วไป และเทียบระหว่างระหว่างอนุภาคกับความยาวคลื่นของเดอบรอยล์ ปรากฏ ว่าไม่ตรงกับในกรณีของกําชทั่วไป จึงอาศัยหลักสถิติของเฟร์มี-ดิแรก และหลักกีดกันของเพาลี รวมทั้งสปินของอิเล็กตรอนซึ่งอาจอยู่ในทิศขึ้นหรือลง ซึ่งสองคล้องกับระบบอิเล็กตรอนอิสระ ในโลหะโดยมีพลังงานเฉลี่ยที่ศูนย์สัมบูรณ์ไม่เป็นศูนย์

กิจกรรมการเรียนที่ 3

1. ทบทวนเนื้อหาหัวข้อที่ 3 จากตำราเรียนด้วยตนเองแบบโปรแกรมสำหรับ กระบวนการวิชานี้ (รหัสการพิมพ์ 29241) หน้า 505-518 หรือพังคำบรรยายสรุปจากแบบคำบรรยายสรุปสำหรับกระบวนการวิชานี้ ครั้งที่ 10 (ดูบันทึกท้ายเล่ม) ประกอบแผ่นภาพโปรดใส่ แผ่นที่ 61-62 (ดูต้นแบบท้ายเล่มนี้)

2. แสดงระยะห่างระหว่างโมเลกุลโดยเฉลี่ยและความยาวคลื่นของเดอบรอยล์ สำหรับกําช อุ่นคติและกําช อิเล็กตรอนว่าแตกต่างกันอย่างไร

3. เปรียบเทียบพังก์ชันการแจกแจงของอิเล็กตรอนอิสระที่อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์ กับที่อุณหภูมิอื่น ๆ

(หน้า 519-531)

การหาค่าต่าง ๆ ของอิเล็กตรอนอิสระ

ค่าอธิบายคัพท์/จำนวน

1. พลังงานทั้งหมดของกําช อิเล็กตรอน คือ พลังงานทั้งหมดของอิเล็กตรอนอิสระในโลหะ ซึ่งมีค่าไม่เป็นศูนย์ที่ศูนย์สัมบูรณ์ และที่อุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้อิเล็กตรอนมีพลังงานสูงขึ้นเล็กน้อย จากพลังงานสูงสุดที่อิเล็กตรอนอิสระในโลหะจะมีได้ที่อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์ (พลังงานเฟร์มี)
2. ความร้อนจำเพาะของอิเล็กตรอนอิสระในโลหะ คือ ความจุความร้อนต่อมอลของ

อิเล็กตรอนอิสระในโลหะ ซึ่งเมื่อห่างจากความสัมพันธ์กับพลังงานภายในของอิเล็กตรอนอิสระ ในโลหะจะเป็นความร้อนจำเพาะที่ปริมาตรคงที่ โดยขึ้นกับอุณหภูมิ ดังนั้นจึงมีค่าเป็นศูนย์ที่ ศูนย์สัมบูรณ์ (สำหรับความร้อนจำเพาะของกําช อุดมคติที่ศูนย์สัมบูรณ์มีค่าไม่เป็นศูนย์) และมีค่าน้อยมากที่อุณหภูมิได้ ๆ

3. ความดันของกําชอิเล็กตรอน คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงพลังงานต่อปริมาตร ซึ่งจะลดลงเมื่อมีปริมาตรเพิ่มขึ้น และมีค่าขึ้นอยู่กับอุณหภูมิตามความสัมพันธ์ของพลังงาน โดยมีค่ามากกว่าความดันของกําชทั่วไปหลายแสนเท่าที่ศูนย์สัมบูรณ์ แต่ไม่สามารถทำให้อิเล็กตรอนหลุดพ้นจากผิวโลหะได้ เนื่องจากการขัดขวางของพลังงานศักย์ซึ่งเรียกว่า กำแพงศักย์

สรุปประเด็นสำคัญ

การหาค่าต่าง ๆ ของอิเล็กตรอนอิสระจะหาได้จากพิธีชันการแยกเฉลี่ยวัสดุอิเล็กตรอน อิสระ เช่น พลังงานทั้งหมดของระบบจะเท่ากับผลรวมของพลังงานของอนุภาคทุกตัวซึ่งนับว่า เป็นพลังงานภายในของระบบ จึงหาค่าความร้อนจำเพาะที่ปริมาตรคงที่จากความสัมพันธ์กับ พลังงานภายใน และหาค่าเอนโทรปีจากความสัมพันธ์กับค่าความจุความร้อน สำหรับค่าอื่น ๆ จะหาได้จากการสัมพันธ์กับค่าข้างต้นนี้ ตามที่ได้ศึกษาแล้วในอุณหพลศาสตร์แผนเดิม ซึ่ง เมื่อเปรียบเทียบค่าที่ได้ในกรณีนี้กับกรณีของกําชทั่วไปจะแตกต่างกันมาก และสอดคล้องกับ ผลการทดลองรวมทั้งกฎที่เกี่ยวข้องด้วย

กิจกรรมการเรียนบทที่ 4

1. ภาพที่มาน้องหน้าที่ 4 จัดการเรียนรู้แบบองค์รวมไปร่วมกันสำหรับ
กระบวนการนี้ (รหัสการพิมพ์ 29241) หน้า 53-53 หรือห้องเรียนภาษาอังกฤษจากแบบคำ
นารายณ์ตราบสานั่นรับการอนุมัติวันวิสาขัน ครั้งที่ 10 (ดูนิพัทธ์แนบเล่ม)

2. ทิจาระนาค่าว่างๆ ของอิเล็กตรอนอิสระโดยเท่าที่ศูนย์สัมบูรณ์ว่ามีค่าเป็น
ศูนย์หรือไม่เป็นศูนย์ในกรณีใดบ้าง เพื่อระหบสูตร

การประเมินผลท้ายบทที่ 9

จะเลือกค่าตอบที่ถูกต้องจากค่าสามต่อไปนี้

(ดูค่าสามใน ทดสอบ 9 กรอบที่ 9-80 ถึง 9-83 ในหน้า 534-536 ในตำราหัศการพิมพ์ 29241)

2. จงทำ แบบฝึกหัด 9 ในกรอบที่ 9-84 ถึง 9-93 ในหน้า 536-543 ในตำราหัศการพิมพ์ 29241